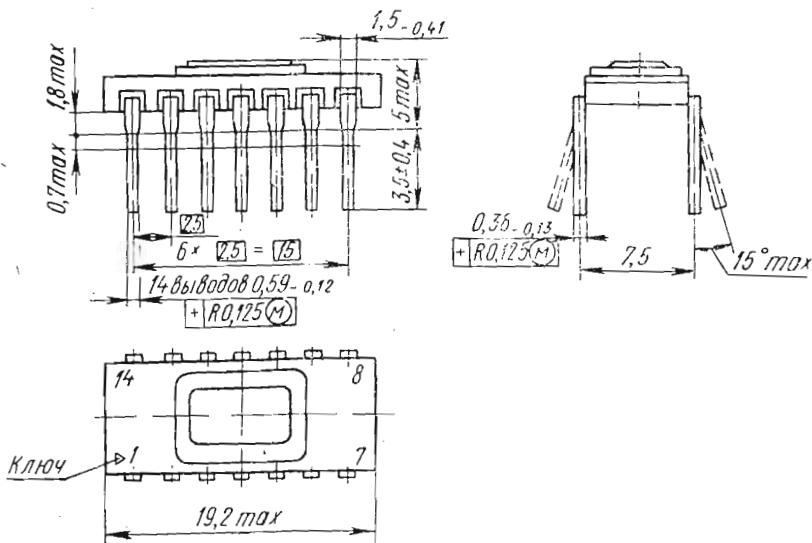


# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 1401

## Общие данные

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

(корпус 201.14-10)



Масса не более 2 г

### ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

#### Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц . . . . .	от 1 до 5 000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	400 (40)

#### Механический удар:

##### одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	15 000 (1 500)
длительность действия ударного ускорения, мс . . . . .	от 0,1 до 2,0

##### многократного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	1 500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс . . . . .	от 1 до 5

Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	5 000 (500)
--	-------------

# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 1401

## Общие данные

Акустический шум:	
диапазон частот, Гц . . . . .	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ . . . . .	170
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.) . . . . .	$1,3 \cdot 10^{-4}$ ( $10^{-6}$ )
Атмосферное повышенное давление, атм . . . . .	3
Повышенная температура среды, °С . . . . .	125
Пониженная температура среды, °С . . . . .	минус 60
Изменение температуры среды, °С . . . . .	от минус 60 до +125
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

## НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч . . . . .	100 000
Срок сохраняемости*, лет . . . . .	25

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 0398—87 и требованиями, изложенными ниже.

Установка и извлечение микросхем из контактирующих устройств должны производиться при выключенных источниках питания.

Микросхемы могут применяться при подключении сопротивления нагрузки к положительному полюсу источника питания при использовании однополярного питания.

Микросхемы могут эксплуатироваться при входном дифференциальном напряжении, не превышающем  $2|U_n - 2|$  В при двухполярном питании и  $|U_n - 2|$  В при однополярном питании, при этом напряжение на каждом входе микросхемы не должно выходить за пределы напряжения источников питания.

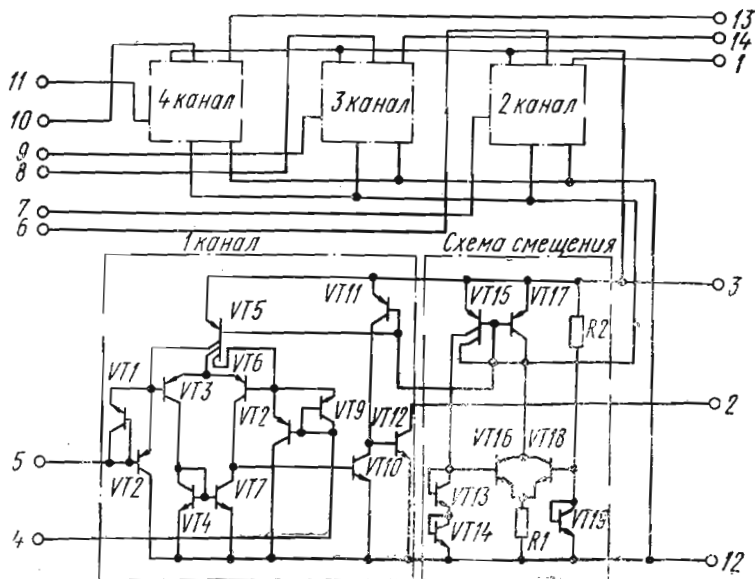
Допустимое значение статического потенциала 100 В для микросхемы 1401УД2 (А, Б) и 30 В для микросхем 1401СА1, 1401УД4.

\* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

СЧЕТВЕРЕННЫЙ КОМПАРТОР  
НАПРЯЖЕНИЯ

1401СА1

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



- |   |   |
|---|---|
| 1 — выход второго канала                | 8 — вход инвертирующий третьего канала      |
| 2 — выход первого канала                | 9 — вход неинвертирующий третьего канала    |
| 3 — $U_n$                               | 10 — вход инвертирующий четвертого канала   |
| 4 — вход инвертирующий первого канала   | 11 — вход неинвертирующий четвертого канала |
| 5 — вход неинвертирующий первого канала | 12 — минус $U_n$                            |
| 6 — вход инвертирующий второго канала   | 13 — выход четвертого канала                |
| 7 — вход неинвертирующий второго канала | 14 — выход третьего канала                  |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре  $25 \pm 10^\circ\text{C}$ )

Напряжение питания, В . . . . .	от 3 до 30
Ток потребления, мА, не более . . . . .	2
Напряжение смещения нуля, мВ, не болес . . . . .	$\pm 5$

Выходное напряжение низкого уровня, мВ, не более . . . . .	400
Входной ток, нА, не более . . . . .	100
Разность входных токов, нА . . . . .	$\pm 25$
Выходной ток, мА, не менее . . . . .	6
Выходной ток утечки, мкА, не более . . . . .	1
Коэффициент усиления, не менее . . . . .	$50 \cdot 10^3$
Время задержки, мкс, не более . . . . .	3

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение питания, В:	
минимальное . . . . .	3
максимальное . . . . .	33
Максимальный размах дифференциального входного напряжения, В . . . . .	$U_n - 1,5$
Выходное напряжение, В . . . . .	от 0 до 33
Максимальное входное синфазное напряже- ние, В . . . . .	$U_n - 1,5$